

Физика и техника полупроводников, 2025, том 59, выпуск 4

Международная конференция ФизикА.СПб/2025

189

Салий Р.А., Малевская А.В., Малевский Д.А., Минтаиров С.А., Надточий А.М., Калюжный Н.А.

Экспериментально-аналитическое исследование проблемы компенсации механических напряжений в системе InGaAs множественных квантовых ям для излучателей ближнего инфракрасного диапазона

190

Сибирев Н.В., Штром И.В.

Управление направлением роста планарных нитевидных нанокристаллов

195

Стецюра С.В., Харитонов П.Г., Козловский А.В.

Модификация поверхности CdS при нанесении и отжиге структурированного металлом органического покрытия

199

Покровский П.В., Хвостиков В.П., Малевская А.В., Хвостикова О.А.

Особенности тестирования микроразмерных фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения

205

Романчук А.К., Малевская А.В., Калюжный Н.А., Нахимович М.В., Шварц М.З., Андреев В.М.

Увеличение эффективности ввода оптической мощности в AlGaAs/GaAs фотоэлектрических преобразователях лазерного излучения

209

Левина С.А., Емельянов В.М., Корниенко П.Д., Ларионов В.Р., Нахимович М.В., Шварц М.З.

Исследование времен жизни неравновесных носителей заряда электролюминесцентным методом в многопереходных солнечных элементах при облучении протонами и электронами высоких энергий

214

Минтаиров М.А., Евстропов В.В., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Нахимович М.В., Шварц М.З.

Определение дисбаланса фотогенерированных токов в многопереходных фотопреобразователях лазерного излучения

219

Михайлов О.П., Баранов А.И., Максимова А.А., Уваров А.В., Вячеславов Е.А., Гудовских А.С.

Исследование влияния облучения потоком электронов на фотоэлектрические свойства солнечных элементов на основе наноструктурированного "черного" кремния с пассивирующим слоем n-GaP

223

Лебедев А.А., Козловский В.В., Малевский Д.А., Сахаров А.В., Давыдовская К.С., Левинштейн М.Е., Николаев А.Е.

Влияние температуры облучения на скорость удаления носителей в GaN

227

Елисеев И.А., Kurtash V.A., Pezoldt J., Давыдов В.Ю.

Управление плотностью носителей заряда в фототранзисторных структурах на основе CVD-MoS₂ толщины

230

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Блошкин А.А., Якимов А.И.

Повышение эффективности фотоприемных структур на основе квантовых точек Ge/Si модами фотонного кристалла в среднем инфракрасном диапазоне

235

Физика полупроводниковых приборов

Демидов Е.В., Захаров В.Е., Шмагин В.Б., Яблонский А.Н., Новиков А.В.

Моделирование транспортных и излучательных характеристик светоизлучающего латерального кремниевое р+-i-n+-транзистора с самоформирующимися Ge(Si)-наноструктурами

242